



Universität Stuttgart



Institut für
Robuste
Leistungshalbleitersysteme

Fachpraktikum (Bachelor)

6G HARDWARELABOR - DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG EINES HF TRANSCEIVERS

Versuch 2: Auslegung eines HF-Verstärkers

Protokollführer

Lukas Müller

Erik Zimmermann

Farhad Valizada

Betreuer

Simon Haussmann

Eingereicht

May 18, 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
1 Einleitung(Farhad)	4
1.1 Ziel des Versuchs	4
1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern	4
2 Theoretische Grundlagen(Lukass)	5
2.1 Funktion eines HF-Verstärkers	5
2.2 Arbeitspunkteinstellung	5
2.3 Bedeutung der S-Parameter	5
2.4 (rolle kopplungskodensator)	5
3 HF-Simulation(Charhad)	6
3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)	6
3.1.1 Installation von ADS	6
3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts	6
3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche	6
3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W	7
3.3 DC-Simulation	7
3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes	8
3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers	9
3.4 S-Parameter-Simulation	10
3.5 Fazit	11
4 Technische Umsetzung(Erik)	13
4.1 Platinen Aufbau	13
4.2 DC-Pegel Verifizieren	13
4.3 Kalibrierung	13
4.4 Vergleich zur Simulation	13
5 Diskussion der Ergebnisse(GangBang)	15
5.1 Vergleich von Theorie und Praxis	15
5.2 Erklärung von Abweichungen	15
6 Fazit(Jeder)	16
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	16
6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen	16
6.3 Eigene Reflexion	16

6.3.1	Erik	16
6.3.2	Farhad	16
6.3.3	Lukas	16
Literaturverzeichnis		17

Abkürzungsverzeichnis

ADS	Advanced Design System
HF	Hochfrequenz
6G	Sixth Generation
SMA	SubMiniature version A
PCB	Printed Circuit Board

Kapitel 1

Einleitung(Farhad)

1.1 Ziel des Versuchs

blabla test

1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern

blabla

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen(Lukass)

2.1 Funktion eines HF-Verstärkers

Ein Verstärker ist ein elektronisches Gerät, mit mindestens einem aktiven Bauelement wie zum Beispiel einem Transistor. Das Ziel eines Verstärkers ist dass, das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal ist. Da hierbei dem Signal Leistung hinzugefügt wird, muss ein Verstärker eine eigene Energiequelle haben.

Besonders in der Hochfrequenztechnik (HF) spielt der Verstärker eine wichtige Rolle. Soll zum Beispiel mithilfe einer Antenne noch in weiter Entfernung ein Signal gemessen werden, muss dies zuerst verstärkt werden.

Normalerweise werden im Hochfrequenzbereich Frequenzen von 10 kHz bis 100.000 MHz verstärkt.

2.2 Arbeitspunkteinstellung

2.3 Bedeutung der S-Parameter

2.4 (Rolle Kopplungskondensator)

blabla

Kapitel 3

HF-Simulation(Charhad)

3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)

3.1.1 Installation von ADS

Die Software Advanced Design System ([ADS](#)) dient zur Simulation von Schaltungen verschiedener Komplexitätsgrade. In diesem Versuch wird die Software verwendet, um eine Hochfrequenzschaltung zu simulieren und zu analysieren. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Schaltungen zu entwerfen, S-Parameter zu simulieren und verschiedene Analysewerkzeuge zu verwenden.

3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Die Software ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert gewesen. Nach dem Start der Software wird ein neues Projekt aus den bereits zur Verfügung stehenden Workspaces erstellt. Diese sind auf der ILIAS-Seite des Praktikums in dem Dateiarchiv `TransmitterAmpDesign 2024.zip` hinterlegt. Die Datei wird entpackt und in der Software geöffnet. Außerdem werden die benötigten Bibliotheken aus dem Dateiarchiv `Infineon-RFTransistor-Keysight ADS Design Kit-SM-v02 10-EN.zip` geladen, diese stehen ebenfalls auf der ILIAS-Seite zur Verfügung.

3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche

Schließlich werden die Tutorials 1 und 2 von [ADS](#) durchgearbeitet, um sich mit der Benutzeroberfläche und den grundlegenden Funktionen der Software vertraut zu machen.

Am Anfang der Schaltungsanalyse wird das Schema `TX_Amp_Bias.dds` geöffnet. Diese ist in der Abbildung 3.1 zu sehen.

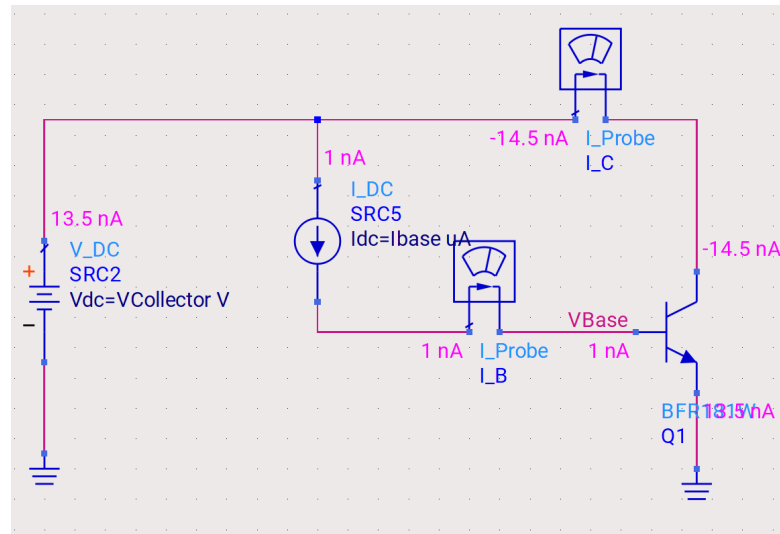


ABBILDUNG 3.1: Schaltbild der Schaltung `TX_Amp_Bias.dds` in ADS.

3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W

Um die Schaltung zu simulieren, wird der Transistor BFR181W verwendet. Um die genauen Parameter des Transistors zu kennen, wird das Datenblatt des Transistors analysiert. Dieses steht auch auf der ILIAS-Seite des Praktikums zur Verfügung.

Die Tabelle “Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified” unten links auf Seite 1 des Dokuments zeigt, dass der maximal zulässige Kollektorstrom $I_{C,\text{max}}$ 20 mA beträgt.

3.3 DC-Simulation

Im folgendem wird eine DC-Simulation der später aufzubauenden Schaltung durchgeführt. Außerdem werden die Arbeitspunkte optimal durch die Anpassung der Widerstandswerte eingestellt. Die DC-Simulation wird in ADS durchgeführt, um die DC-Pegel der Schaltung zu überprüfen.

3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes

Folgende Spannungswerte werden angenommen:

- $U_{CC} = 4.8 \text{ V}$
- $U_{BE} = 0.77 \text{ V}$

Zuerst wird der Kollektorwiderstand R_5 passend gewählt, sodass der Kollektorstrom I_C auf 75 % des maximal zulässigen Kollektorstroms $I_{C,\max}$ gesetzt wird. Dies geschieht, indem der Widerstandswert R_5 so gewählt wird, dass der Kollektorstrom I_C 15 mA beträgt. Der Widerstandswert R_5 wird mit folgender Formel berechnet:

$$R_5 = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{4.8 \text{ V}}{15 \text{ mA}} = 320 \Omega \quad (3.1)$$

Bei der Verwendung der E12-Reihe wird eine Faustregel verwendet, nach der man die Widerstandswerte auf die nächstgelegene E12-Reihe aufrundet. Somit beträgt der errechnete Widerstandswert von R_5 330 Ω . Dadurch wird der in den Kollektor eingehende Strom beschränkt, was eine Überlastung des Transistors im Dauerbetrieb vorbeugt. Bei der Wahl eines niedrigeren Widerstandswertes würde der Kollektorstrom I_C den maximalen Kollektorstrom $I_{C,\max}$ überschreiten, was zu einer Überlastung des Transistors führen würde.

Dieses Ergebnis lässt sich anhand der Simulation in [ADS](#) verifizieren. Es wird ein Sweep des Kollektorwiderstandes R_5 in der Spanne von 100 Ω bis 4,7 k Ω durchgeführt. Es ergibt sich der folgende Verlauf des Kollektorstroms I_C in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes R_5 :

Einstellung Arbeitspunkt

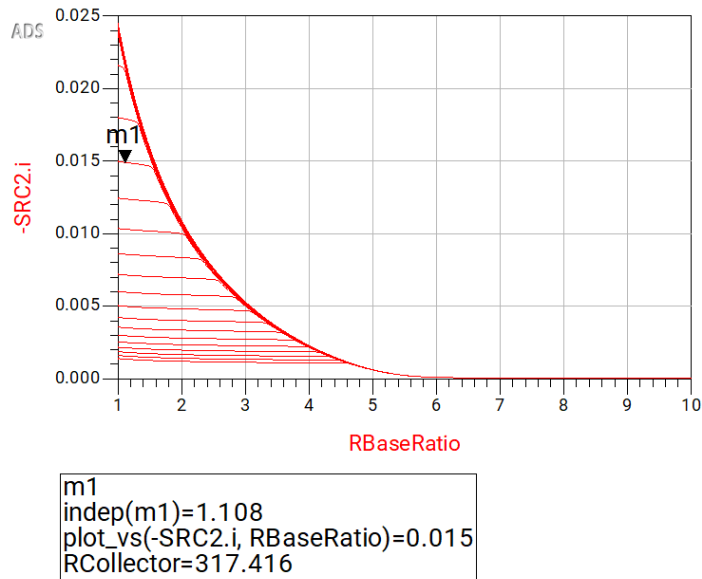


ABBILDUNG 3.2: Verlauf des Kollektorstroms I_C in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes R_5 .

Aus der Abbildung 3.2 ist zu erkennen, dass der Kollektorstrom I_C mit steigendem Kollektorwiderstand R_5 abnimmt. Mit dem Marker m1 wird außerdem gezeigt, dass der Kollektorstrom I_C bei einem Widerstandswert von 317,416 Ω einen Wert von 15 mA erreicht. Es wird der nächstgrößere Widerstandswert der E12-Reihe gewählt, also 330 Ω . Die Ergebnisse der Rechnung wurden also somit bestätigt.

3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers

Um einen Arbeitspunkt mit $I_C \approx 10$ mA zu erreichen, wird der Basis-Spannungsteiler dimensioniert. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt $U_{BE} \approx 0,7$ V. Der Emitterwiderstand wird hier vernachlässigt.

Der Basisstrom berechnet sich zu:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (3.2)$$

Für einen typischen Verstärkungsfaktor $\beta = 100$ ergibt sich:

$$I_B = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA} = 100 \mu\text{A} \quad (3.3)$$

Der Querstrom des Spannungsteilers I_Q sollte mindestens das 10-fache des Basisstroms betragen:

$$I_Q = 10 \cdot I_B = 1,0 \text{ mA} \quad (3.4)$$

Die Basisspannung U_B ergibt sich zu:

$$U_B = U_{BE} + U_E \approx 0,77 \text{ V} \quad (3.5)$$

Angenommen, die Betriebsspannung ist $U_{CC} = 4,8 \text{ V}$, ergibt sich für die Widerstände R_4 (oben) und R_3 (unten):

$$R_3 = \frac{U_B}{I_Q} = \frac{0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 0,77 \text{ k}\Omega \quad (3.6)$$

$$R_4 = \frac{U_{CC} - U_B}{I_Q} = \frac{4,8 \text{ V} - 0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 4,03 \text{ k}\Omega \quad (3.7)$$

Nach der Berechnung ergibt sich für R_3 ein Wert von $0,77 \text{ k}\Omega$. In der praktischen Simulation mit ADS zeigte sich jedoch, dass mit diesem Wert ein negatives Gain bei der S-Parameter-Simulation auftritt. Daher wird R_3 nach der E12-Reihe auf $1,0 \text{ k}\Omega$ erhöht, um einen stabilen Arbeitspunkt und ein positives Verstärkungsverhalten zu gewährleisten.

Mit der E12-Reihe werden gewählt:

$$R_3 = 1,0 \text{ k}\Omega$$


$$R_4 = 4,7 \text{ k}\Omega$$

Damit ist der Spannungsteiler dimensioniert, sodass im Arbeitspunkt ein Kollektorstrom von ca. 10 mA zu erwarten ist und die Simulation ein positives Gain liefert.

3.4 S-Parameter-Simulation

Schließlich wird die S-Parameter-Simulation durchgeführt. Diese ist wichtig, um einen angemessenen Gain bei der Übertragung zu gewährleisten. Die S-Parameter-Simulation wird in [ADS](#) nach folgenden Schritten durchgeführt:

1. Im ADS-Model wird die Kommentierung des S-Parameter-Controllers aufgehoben, also die S-Parameter-Einstellung wird aktiviert.
2. Da jetzt die DC-Simulation überflüssig ist, wird diese deaktiviert.

3. Vor der Simulation wird die Schrittweite des S-Parameter-Controllers auf 250 MHz gesetzt, sodass man die Qualität des Frequenz-Sweeps verbessert. 
4. Nach der Simulation wird das Ergebnis in einem neuen Fenster angezeigt. Es ergibt sich der folgende Verlauf des Gains für verschiedene Frequenzen:

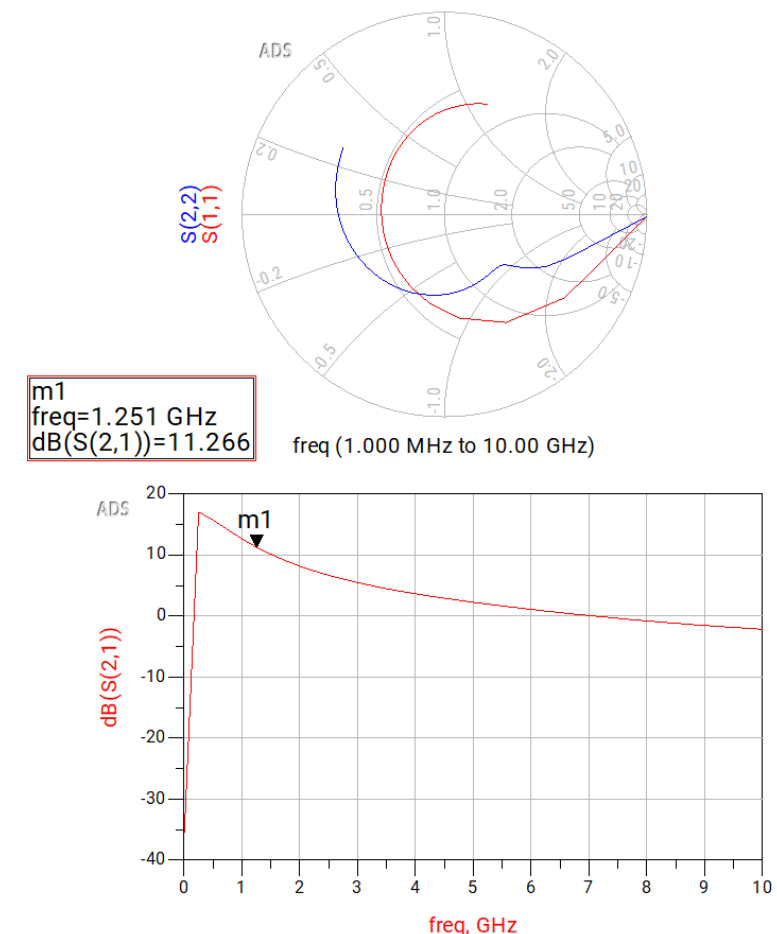



ABBILDUNG 3.3: Ergebnisse der S-Parameter-Simulation.

Hier wählt man die Schaltfläche “Insert A New Marker” aus . Wir setzen den Marker auf den Punkt unserer Arbeitsfrequenz, also bei 1,25 GHz (s. Abbildung 3.3). Der Marker m1 zeigt eine **Verstärkung (Gain) von 11,266 dB** an.

3.5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Simulation der Hochfrequenzschaltung mit ADS erfolgreich durchgeführt wurde. Die Dimensionierung der Widerstände wurde erfolgreich durchgeführt, um einen stabilen Arbeitspunkt zu erreichen. Auch die S-Parameter-Simulation zeigte ein positives Gain von 11,266 dB bei einer Frequenz von

1,25 GHz. Die Ergebnisse der Simulation stimmen mit den theoretischen Berechnungen überein. Die Software [ADS](#) erwies sich als nützliches Werkzeug zur Analyse und Simulation von Hochfrequenzschaltungen.

Kapitel 4

Technische Umsetzung(Erik)

4.1 Platinen Aufbau

4.2 DC-Pegel Verifizieren

4.3 Kalibrierung

4.4 Vergleich zur Simulation

adkafdkadfasdkl

Kapitel 5

Diskussion der Ergebnisse(GangBang)

5.1 Vergleich von Theorie und Praxis

5.2 Erklärung von Abweichungen

bla bla

Kapitel 6

Fazit(Jeder)

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen

6.3 Eigene Reflexion

6.3.1 Erik

6.3.2 Farhad

6.3.3 Lukas

bla bla

Literaturverzeichnis

- [1] Infineon Technologies AG: *BFR181W Silicon NPN RF Transistor*, Datenblatt, 2017. Online verfügbar unter: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFR181W-DS-v02_00-en.pdf
- [2] <https://www.atecorp.com/solutions/what-is-an-rf-amplifier> (zugegriffen am 17.04.2025)
- [3] [https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_\(Elektrotechnik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)) (zugegriffen am 17.04.2025)